

أسس الالكترونيات

كتب عربية وايلي في الهندسة

احمد / الكاتب : أسس الالكترونيات

الجارالله / نوارة : إدارة المشاريع الهندسية

حمد : الاقتصاد الهندسي ، الطبعة الثانية

حانسن : أسس الري وعملياته ، الطبعة الرابعة

الدخاخني : مقاومة المواد

شواب : المبادئ الأولية في هندسة الأراضي والمياه ، الطبعة الثانية

غولد هابر : النظم الإدارية هندسة التشيد

فان وايلن : أسس الديناميكا الحرارية الكلاسيكية ، الطبعة الثانية SI

مریام : الميكانيكا الهندسية ، الجزء الأول ، الاستاتيكا ، الطبعة SI

مریام : الميكانيكا الهندسية ، الجزء الثاني ، الديناميكا ، الطبعة SI

وست : تحليل الانشاءات

أسس الالكترونيات

د/محمد فاروق أحمد
د/محمد حضر كاتب
قسم الفيزياء — كلية العلوم — جامعة الملك سعود

الناشر

الناشر : جامعة الملك سعود
ص . ب : ٢٤٥٤ الرياض — المملكة العربية السعودية

و

جون وايلي وأولاده
نيويورك . شيشستر . برلين . تورنتو . سنغافورة

PRINCIPLES OF ELECTRONICS
by M. F. Ahmad and M. K. Katib

Copyright © 1984 by John Wiley & Sons, Inc.

All Rights Reserved. Published simultaneously in England by John Wiley & Sons, Ltd.

No part of this book may be reproduced by any means, nor transmitted, nor translated into a machine language without the written permission of the publisher.

Printed in Malta

حقوق النشر للطباعة العربية © سنة ١٩٨٤ محفوظة لدار جون وايلي وأبنائه . جميع الحقوق محفوظة .
يتم نشر هذا الكتاب في ذات الوقت — في إنجلترا بواسطة دار جون وايلي وأبنائه لميتد .
لا يجوز إعادة طبع أو نقل أو ترجمة أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأية وسيلة دون إذن كتابي من
الناشر .

ISBN 0-471-88556-8
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته . . . وبعد ، تفتقر المكتبة العربية عموماً إلى المراجع العلمية العربية في شتى فروع العلوم الأساسية والتطبيقية . وبعاني الطلبة الجامعيون كثيراً — وخصوصاً طلبة المستويات الأولى — من عدم وجود مراجع علمية عربية تغطي ما يدرسوه من مقررات . وحتى في حالة وجود بعض من هذه المراجع العلمية العربية فإنه يلاحظ أنها لا تتمشى مع جميع محتويات المقررات التي يدرسونها والتي تتغير بصفة مستمرة لتسارع التطور السريع في مختلف فروع العلم . وبالنسبة لعلم الإلكترونيات يلاحظ أن معظم المراجع العربية قد وضع لمستوى طلبة المعاهد الفنية المتوسطة . وأما بالنسبة للمستوى الجامعي فإنه فضلاً عن ندرة المراجع العربية يلاحظ عدم مسايرتها للتطور السريع في هذا المجال أو عدم شموليتها على جميع الجوانب التي يجب أن يلم بها الطلبة . لذا فإنه لا يمكن إختيار مرجع عربي واحد أو حتى عدة مراجع بحيث يمكن أن تغطي محتويات مقررات الإلكترونيات التي يدرسونها . وهذا الكتاب عبارة عن محاولة متواضعة لعمل مرجع دراسي عربي في أساس الإلكترونيات . وقد روّعي عند وضعه أن يشتمل على الأبواب التي تغطي محتويات مقرر الإلكترونيات لطلبة المستوى الثاني بكليات العلوم والتربية ، آخذين في الإعتبار إمكانية تغيير بعض محتويات هذا المقرر خلال سنوات قليلة .

وتحتوي الكتاب على عشرة أبواب . خصص الباب الأول والثاني منها للدراسة حرفة الإلكترونيات في المجالات الكهرومغناطيسية وفيزياء الإلكتروني في المادة . ونظراً للتتحول السريع من الصمامات الإلكترونية إلى العناصر الإلكترونية المجهزة من أشباه الموصلات فقد خصص للصمامات بابان فقط . أحدهما للدراسة الأساسية الفيزيائية للصمامات المختلفة (الباب الثالث) والآخر (الباب السابع) للتعرف على الدارات الأساسية للتكيير بإستخدام هذه الصمامات . وأما الأبواب rest الباقي فهي مخصصة لدراسة فيزياء أشباه الموصلات مثل الثنائيات والترانزستورات المختلفة وإستخدام هذه العناصر الإلكترونية في بعض الدارات الإلكترونية الأساسية وخاصة دارات التكبير . ونظراً لأهمية التغذية الخلفية في الدارات الإلكترونية فقد خصص لها مع المذبذبات باب كامل .

وقد توخيتنا في عرض الموضوعات سهولة العبارة ووضوح المعنى كما إلتزمنا في ترتيب المادة العلمية بما جاء في مقرر الإلكترونيات . ونأمل أن تكون قد قدمتنا للطالب — من خلال هذا العمل المتواضع — ما يساعدة على فهم وإستيعاب أساسيات هذا الفرع من فروع المعرفة .
نسأل الله أن يجعل فيه نفعاً وفائدة للطلبة . والله من وراء القصد .

فهرس الكتاب

	الباب الأول : حركة الإلكترون في المجالات الكهرومغناطيسية
١١	١—١ حركة الإلكترون في مجال كهربائي ثابت
١٣	٢—١ وحدة الطاقة — إلكترون فولت
١٣	٣—١ حركة الإلكترون في مجال كهربائي عرضي
١٦	٤—١ الإنحراف الإلكترونيستاتيكي
١٧	٥—١ راسم الذبذبات
١٩	٦—١ سريان التيار في الفراغ
١٩	٧—١ حركة الإلكترون في المجال المغناطيسي المتجلانس
٢٣	٨—١ حركة الإلكترونات في مجالات كهربائية ومغناطيسية متعامدة — الماغنيتون
٢٥	٩—١ أنبوب أشعة المهبط ذات الإنحراف المغناطيسي
٢٧	١٠—١ البصريات الإلكترونية
٢٧	١١—١ العدسات الكهرومغناطستاتيكية
٢٩	١٢—١ العدسات المغناطيسية
	الباب الثاني : الإلكترونات في المادة
٣٣	٢—١ الإلكترون في الذرة
٣٤	٢—٢ نظرية بوهر للذرة
٣٥	٣—٢ سويات (مناسيب) الطاقة الذرية
٣٦	٤—٢ التركيب الإلكتروني للعناصر
٣٨	٥—٢ جهد الإثارة وجهد التأين
٣٩	٦—٢ قطاعات أو شرائح الطاقة
٤١	٧—٢ العازلات وأشباه الموصلات والموصلات
٤٢	٨—٢ الحركة والتوصيلية في المعادن
٤٤	٩—٢ توزيع طاقة الإلكترونات
٤٦	١٠—٢ الإبعاث (الإصدار) الإلكتروني
٤٧	١١—٢ أنواع الإبعاث الإلكتروني
٤٨	١٢—٢ الإبعاث الأيوني الحراري
٤٨	١٣—٢ أنواع الكاثودات
٤٩	١٤—٢ الإبعاث الثنائي
٥١	١٥—٢ الإبعاث الكهروضوئي
٥٢	١٦—٢ ظاهرة شوتكي والإبعاث الجمالي

الباب الثالث : الصمامات المفرغة

٥٥	٣—٣	الصمام الثنائي المفرغ
٥٦	٣—٢	العمليات الفيزيائية في الصمام الثنائي
٥٧	٣—٣	قانون تشايلد — لأنغمير
٥٩	٣—٤	المميز الإستاتيكي (منحنى الخواص) للصمام الثنائي
٦١	٣—٥	القيم المميزة (بارامترات) للصمام الثنائي
٦٥	٣—٦	المميزة الديناميكية للصمام الثنائي
٦٦	٣—٧	الصمام الثلاثي المفرغ
٦٦	٣—٨	تصميم الصمام الثلاثي وداراته
٦٧	٣—٩	العمليات الفيزيائية في الصمام الثلاثي
٦٨	٣—١٠	قانون قوة الثلاثة أنصاف للصمام الثلاثي
٦٩	٣—١١	مميزات (منحنيات الخواص) الصمام الثلاثي الإستاتيكية
٧٠	٣—١٢	بارامترات الصمام الثلاثي
٧٣	٣—١٣	الصمام الرباعي
٧٤	٣—١٤	مميزات الصمام الرباعي الإستاتيكية
٧٥	٣—١٥	بارامترات الصمام الرباعي
٧٦	٣—١٦	الظاهرة الدايناترونية في الصمامات الرباعية
٧٧	٣—١٧	الصمامات الخجاسية
٧٧	٣—١٨	مميزات الصمام الخجاسي
٧٨	٣—١٩	بارامترات الصمام الخجاسي
٧٩	٣—٢٠	الصمام الرباعي ذو الخزمة الإلكترونية عالية القدرة
٨٥	٣—٢١	الصمامات الغازية
٨١	٣—٢٢	الصمام الثنائي الغازى
٨٢	٣—٢٣	الصمام الثلاثي الغازى

الباب الرابع : أشباه الموصلات

٨٧	٤—٤	أشباه الموصلات الذاتية
٨٩	٤—٤	الحركة الإسقاقية لحاملات الشحنة في مجال كهربى
٩١	٤—٣	انتشار حاملات الشحنة
٩٣	٤—٤	أشباه الموصلات ذات الشوائب
٩٥	٤—٥	الحاملات الغالية والأقلية
٩٥	٤—٦	معدل الإنتاج وإعادة الإتحاد للأزواج
٩٧	٤—٧	أثر هول
٩٨	٤—٨	الثريميستور والستنستيستور
٩٩	٤—٩	الموصلات الضوئية
٩٩	٤—١٠	كيفية مرور التيار في شبه الموصل

الباب الخامس : الثنائيات شبه الموصلة والترانزستورات

١٠١	٥ — ١	ثنائي الموصلة (المتلقى)
١٠٤	٥ — ٢	ثنائي الموصلة (المتلقي) في حالة توصيل جهد
١٠٧	٥ — ٣	التيار المباشر لثنائي الموصلة
١٠٨	٥ — ٤	التيار العكسي لثنائي الموصلة
١٠٩	٥ — ٥	ميزة (منحنى الخواص) الثنائي شبه الموصل
١١٠	٥ — ٦	مقاومة الثنائي شبه الموصل
١١١	٥ — ٧	ساعات الثنائي شبه الموصل
١١٢	٥ — ٨	الثنائي الضوئي شبه الموصل
١١٣	٥ — ٩	الميزة الفولت — أميرية للثنائي الضوئي شبه الموصل
١١٤	٥ — ١٠	الأثر الفوتوفولتي
١١٥	٥ — ١١	الخلية الشمسية
١١٧	٥ — ١٢	ترانزستور الموصلة
١١٨	٥ — ١٣	تحبيب الترانزستور
١١٩	٥ — ١٤	مركبات التيار في الترانزستور
١٢٢	٥ — ١٥	المميزات الإستاتيكية للترانزستور
١٢٣	٥ — ١٦	ميزة التوصيل بقاعدة مشتركة
١٢٥	٥ — ١٧	بارامترات الترانزستور عند التوصيل بقاعدة مشتركة
١٢٦	٥ — ١٨	ميزة التوصيل بباعت مشترك
١٢٨	٥ — ١٩	بارامترات الترانزستور عند التوصيل بباعت مشترك

الباب السادس : بعض استخدامات الثنائيات في الدارات الإلكترونية

١٣٢	٦ — ١	الدارة الأساسية للثنائي وميزة الديناميكية
١٣٧	٦ — ٢	استخدام الثنائي كمحدد للجهاد
١٣٨	٦ — ٣	استخدام الثنائي في بوابة التشكيل
١٤٠	٦ — ٤	استخدام الثنائي في الدارات المنطقية
١٤٢	٦ — ٥	استخدام الثنائي في دارات التقويم

الباب السابع : استخدام الصمامات الثلاثية والرباعية والخمسية في دارات التكبير

١٤٨	٧ — ١	الميزة الديناميكية للصمام
١٥٠	٧ — ٢	نقطة التشغيل
١٥١	٧ — ٣	جهد شبكة التحكم (نقطة التشغيل الذاتي)
١٥٣	٧ — ٤	جهد الشبكة الحاجبة
١٥٣	٧ — ٥	مقاومة الترسّب لشبكة التحكم
١٥٤	٧ — ٦	معامل الكسب لمكير بإستخدام صمام ثلاني

١٥٥	معامل كسب مكير بمقاومة تغذية ذاتية للشبكة	٧ — ٧
١٥٦	معامل كسب المكير في الحالة العامة	٨ — ٧
١٥٨	معاودة الخرج للمكير	٩ — ٧
١٥٩	التابع الكاثودي	١٠ — ٧

الباب الثامن : إستخدام الترانزستور في دارات التكبير		
١٦٣	المكير الترانزستوري بقاعدته مشتركة — معاملات الكسب والدارة المكافحة	١ — ٨
١٦٦	المكير الترانزستوري ذو الباعث المشتركة — معاملات الكسب ودارته المكافحة	٢ — ٨
١٦٨	نقطة التشغيل وخط التحميل الإستاتيكي والديناميكي	٣ — ٨
١٦٩	التحيز الثابت للقاعدة أو نقطة التشغيل الثابتة	٤ — ٨
١٧٠	التحيز من الجمع للقاعدة	٥ — ٨
١٧١	التحيز الذاتي أو الباعثي	٦ — ٨
١٧٤	معاملات الكسب لمكير ترانزستوري ذي تحيز باعثي	٧ — ٨
١٧٥	التابع الباعثي	٨ — ٨
١٧٦	دارات التكبير المرحلية	٩ — ٨
١٧٧	ربط المراحل بإستخدام مقاومة ومكثف . منحي الإستجابة للمكير	١٠ — ٨

الباب التاسع : المكيرات ذات التغذية الخلفية والمذبذبات		
١٨٣	التغذية الخلفية في المكيرات	١ — ٩
١٨٣	معامل كسب المكير في حالة وجود تغذية خلفية	٢ — ٩
١٨٥	أثر التغذية الخلفية على إستقرار معامل الكسب	٣ — ٩
١٨٧	أثر التغذية الخلفية على الشووية اللاخطى	٤ — ٩
١٨٧	أثر التغذية الخلفية على إتساع الشريحة	٥ — ٩
١٨٩	أثر التغذية الخلفية على معاوقي الدخول والخرج للمكير	٦ — ٩
١٩٠	أثر التغذية الخلفية على ضوابط المكير	٧ — ٩
١٩١	دارات التغذية الخلفية	٨ — ٩
١٩٢	التغذية الخلفية الموجية والمذبذبات	٩ — ٩
١٩٣	مذبذب فرق الطور	١٠ — ٩
١٩٥	المذبذبات الخاملة	١١ — ٩
١٩٦	المذبذب عديد الإهتزازات	١٢ — ٩

الباب العاشر : ترانزستور الأثر المجالي		
١٩٩	ترانزستور الأثر المجالي	١ — ١٠
١٩٩	ترانزستور الأثر المجالي ذو الوصلة	٢ — ١٠
٢٠٢	ترانزستور الأثر المجالي ذو البوابة المعزولة	٣ — ١٠

٢٠٤	بارامترات ترانزستور الأثر المجلبي	٤ — ١٠
٢٠٥	تحبيز ترانزستور الأثر المجلبي	٥ — ١٠
٢٠٧	استخدام ترانزستور الأثر المجلبي في دارات التكبير	٦ — ١٠
٢١٠	استخدام ترانزستور الأثر المجلبي كمقاومة متغيرة	٧ — ١٠

المراجع

٢١٣	المصطلحات الإنجليزية العربية
٢٢٠	المصطلحات العربية الإنجليزية